

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ



بسم الله الرحمن الرحيم

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه

آقای محمد رمضانی فرانی پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان ساخت غشاء نانو متخلخل سیلیکا- اکسید قلع در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امنا
استاد راهنمای	دکتر احسان طاهری نساج	دانشیار	احسن طاهری
استاد ناظر	دکتر رسول صراف مأموری	دانشیار	رسول صراف
استاد ناظر	دکتر پروین علیزاده	دانشیار	پروین علیزاده
استاد ناظر	دکتر سیدعلی طبی فرد	استادیار	سیدعلی طبی فرد
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	دکتر رسول صراف مأموری	دانشیار	رسول صراف

آیین نامه چاپ پایان نامه های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت های علمی - پژوهشی دانشگاه است، بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به "دفتر نشر آثار علمی" دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

"کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رمضانی فرانی در رشته مهندسی مواد- سرامیک است که در سال ۱۳۹۰ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر احسان طاهری نساج از آن دفاع شده است".

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به "دفتر نشر آثار علمی" دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأديه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقيف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب محمد رمضانی فرانی دانشجوی رشته مهندسی مواد- سرامیک

قطع کارشناسی ارشد تعهد فوق وضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شوم.

نام و نام خانوادگی: محمد رمضانی فرانی

تاریخ و امضا:

دستور العمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران لازم است اعضای هیات علمی دانشجویان دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح درمورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عناوین پایان نامه وساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است موارد ذیل را رعایت نمایید:

ماده ۱: حقوق مادی و معنوی پایان نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هر گونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی می‌باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنمای نویسنده مسئول مقاله باشند.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنمای یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و هر گونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی و مهندسی

رشته مهندسی مواد-سرامیک

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد- سرامیک

عنوان

ساخت غشاء نانو متخلخل سیلیکا-اکسید قلع

نگارش

محمد رمضانی فرانی

استاد راهنما:

دکتر احسان طاهری نساج

ای ای کریمی که بخشیده عطاوی، ای حکیمی که پوشنده خطای، ای احمدی که در ذات و صفات بی همتای،

ای خالقی که راهنمایی، ای قادری که خدایی را سزاوی، به ذات لایزال خودوبه صفات باحال خودوبه

عزت جلال خودوبه عظمت جمال خودکه جان مارا صفاتی خودده، دل مارا هواستی خودده، چشم مارا

ضیاء خودده و مارا آن ده که آن به.

سایر تنویش طاعقی روزی کن

یارب تو مرا انباتی روزی کن

اندر دو جهان فراغتی روزی کن

زان پیش که فارغ شوم از کار جهان

خواجہ عبدالله انصاری

تقدیم به خانواده عزیزم

سپاس‌گزاری

با سپاس فراوان از راهنمایی‌ها و کمک‌های شایان دکتر احسان طاهری نساج که در به سرانجام رساندن این پایان‌نامه از هیچ گونه کمکی دریغ ننمودند. همچنین از خانم‌ها مریم شجاعی و وجیهه خانی و آقایان محمد خواجه‌لکزای، رضا تفریشی، یعقوب فرهنگ و محمدرضا بلباسی که در این پروژه مرا بسیار یاری نمودند سپاس‌گزارم.

با تشکر فراوان از تمامی اعضا خانواده عزیزم که همیشه و همه حال پشتیبان و همراه من بوده‌اند و آرزوی سلامت و سعادتشان را از خداوند متعال خواستارم.

چکیده

در این تحقیق غشاء میکرومترخانه چندلایه سیلیکا-اکسید قلع، به روش سل-ژل و با استفاده از آلکوکسید تترا اتیل اورتو سیلیکات، آلكوکسید آلومینیم تری سک بوتیلات و دی بوتیل تین دی استات تهیه شد. برای تهیه لایه‌های میانی، سل کلوئیدی آلومینا تهیه شد و به روش غوطه‌وری بر روی زیرلایه آلفا-آلومینا پوشش داده شد. پس از هربار پوشش دهنده نمونه‌ها تا دمای 200°C حرارت داده شدند. پوشش دهنده نمونه‌ها با سل کلوئیدی ۵ مرتبه تکرار شده و در نهایت در دمای 600°C کلسینه شدند. سپس لایه نهایی به روش غوطه‌وری در سل پلیمری سیلیکا-اکسید قلع شکل گرفت. پس از هربار پوشش دهنده نمونه‌ها تا دمای 200°C حرارت داده شدند. پس از ۳ مرتبه پوشش دهنده، نمونه‌ها در دمای 500°C کلسینه شدند.

زیرلایه آلومینیایی تهیه شده، توسط آنالیزهای زبری‌سنجدی و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. سل‌ها و ژل‌های خشک شده و مورد استفاده برای تهیه لایه میانی و لایه نهایی و همچنین پوشش‌ها، با استفاده از آنالیزهای تفکیک پراش نوری (*DLS*)، طیف‌سنجدی عبوری مادون قرمز (*FTIR*)، آنالیزهای حرارتی (*DSC-TGA*)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (*SEM*)، میکروسکوپ اتمی (*AFM*) و آنالیز فازی (*XRD*) مورد بررسی قرار گرفتند.

پوشش سیلیکا-اکسید قلع تا دمای 800°C آمورف بود. آنالیز *FTIR* از نمونه حاوی $10\% \text{ mol}$ قلع فاقد پیک پیوند *Sn-O-Sn* بود. برای تهیه سل لایه میانی با استفاده از حلحل اتانول و افزودنی *PVA* اندازه ذرات در محدوده ۲۵ تا 90 nm و با استفاده از حلحل ایزوپروپانول و افزودنی *PVA*، اندازه ذرات در بازه ۴۰ تا 200 nm بدست آمد. با استفاده از این سل‌های کلوئیدی لایه‌ای به ضخامت $4/6\mu\text{m}$ تهیه شد. برای تهیه لایه نهایی از سل پلیمری سیلیکا-اکسید قلع با اندازه ذرات در محدوده $0/4$ تا $1/5\text{ nm}$ استفاده شده و پوشش با ضخامت حدود 200 nm بدست آمد.

کلمات کلیدی: سل-ژل، غشاء، سیلیکا-اکسید قلع، غوطه‌وری، میکرومترخانه.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	فصل ۱
۲.....	۱-۱ - مقدمه
۸.....	فصل ۲
۹.....	۱-۲ - مقدمه
۱۷.....	۲-۲ - ساختمان غشاء
۱۸.....	۳-۲ - روش‌های ساخت غشاء سرامیکی
۱۸.....	۱-۳-۲ - تهیه غشاء سرامیکی با سینتر جزئی ذرات
۲۱.....	۲-۱-۳-۲ - عوامل مؤثر در ساخت غشاء
۲۳.....	۳-۱-۳-۲ - پروسه کلوئیدی کردن
۲۶.....	۴-۱-۳-۲ - سل پلیمری
۲۷.....	۴-۲ - خصوصیات کلیدی غشاها
۲۸.....	۱-۴-۲ - اندازه حفرات
۲۸.....	۲-۴-۲ - نفوذپذیری
۲۹.....	۳-۴-۲ - خواص مکانیکی
۲۹.....	۴-۴-۲ - مقاومت شیمیایی
۳۰.....	۵-۲ - پوشش سرامیکی با سل-ژل
۳۱.....	۱-۵-۲ - پروسه سل-ژل
۳۷.....	۲-۵-۲ - مکانیزم‌های پوششده
۳۹.....	۲-۲-۵-۲ - فیلتراسیون کلوئیدی موئینگی
۴۰.....	۳-۲-۵-۲ - مکانیزم پوشش دهنده فیلم
۴۱.....	۶-۲ - خشک کردن پوشش
۴۲.....	۷-۲ - سینتر کردن
۴۳.....	۱-۷-۲ - سینتر حالت ساختار آزاد
۴۴.....	۸-۲ - انتقال از درون غشاء
۴۷.....	۳ - فصل ۳
۴۸.....	۱-۳ - زیرلايه

۴۸.....	۱-۱-۳- مواد اولیه
۴۸.....	۲-۱-۳- روش ساخت زیرلايه
۴۸.....	۲-۲-۳- لایه میانی
۴۸.....	۱-۲-۳- مواد اولیه
۴۹.....	۲-۲-۳- روش تهیه سل کلوئیدی
۴۹.....	۳-۳-۳- لایه نهایی
۴۹.....	۱-۳-۳- مواد اولیه
۴۹.....	۲-۳-۳- روش تهیه سل سیلیکا-اکسید قلع
۵۰.....	۴-۳- پوشش دهی
۵۱.....	۵-۳- عملیات حرارتی
۵۱.....	۱-۵-۳- سیکل خشک کردن و سینتر جزئی پوشش کلوئیدی
۵۳.....	۲-۵-۳- سیکل خشک کردن و سینتر جزئی پوشش پلیمری
۵۴.....	۶-۳- روش های ارزیابی زیرلايه
۵۴.....	۷-۳- روش های ارزیابی غشاء
۵۵.....	۱-۷-۳- تکیک پراش نوری (<i>DLS</i>)
۵۵.....	۲-۷-۳- آنالیز حرارتی
۵۵.....	۳-۷-۳- آنالیز فازی (<i>XRD</i>)
۵۵.....	۴-۷-۳- آنالیز طیف سنجی عبوری مادون قرمز (<i>FIIR</i>)
۵۶.....	۵-۷-۳- آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (<i>SEM & FESEM</i>)
۵۶.....	۶-۷-۳- آنالیز میکروسکوپ اتمی <i>AFM</i>
۵۷.....	فصل ۴

۵۸.....	۱-۴- بررسی زیرلايه آلمینایی
۶۰.....	۲-۱-۴- بررسی زبری سطح زیرلايه آلمینایی
۶۴.....	۲-۲-۴- بررسی سل لایه میانی
۶۸.....	۲-۲-۴- تأثیر نوع حلال بر اندازه ذرات سل کلوئیدی
۶۹.....	۳-۲-۴- تأثیر افزودنی <i>PVA</i> بر اندازه ذرات سل کلوئیدی
۷۱.....	۴-۲-۴- تأثیر پیرسازی بر اندازه ذرات سل کلوئیدی
۷۳.....	۳-۴- فارشناسی لایه میانی
۷۵.....	۴-۴- تهیه لایه میانی
۷۵.....	۱-۴-۴- تشکیل لایه میانی گاما-آلومینا بر روی زیرلايه
۸۴.....	۵-۴- انتخاب مواد اولیه لایه نهایی

۴-۶- بررسی خصوصیات سل پلیمری سیلیکا-اکسید قلع با استفاده از آنالیز <i>DLS</i>	۸۵
۴-۷- تست طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز	۸۸
۴-۸- آنالیز حرارتی پوشش سیلیکا-اکسید قلع	۹۶
۴-۹- فازشناسی پوشش سیلیکا-اکسید قلع	۹۷
۴-۱۰- تشکیل لایه نهایی سیلیکا-اکسید قلع بر روی لایه میانی	۱۰۰
فصل ۵	۱۱۰

۱-۱- نتیجه‌گیری	۱۱۱
۲-۲- پیشنهادات	۱۱۳
مراجع	۱۱۴

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل(۱-۲) سیستمهای مختلف انواع غشاها	۱۰
شکل(۲-۲) دو نوع سیستم در غشاء‌ها : واکنش و جدایش در یک واحد(سمت چپ) و واکنش در یک واحد و جدایش در واحدی دیگر(سمت راست)	۱۵
شکل(۳-۲) تصویر شماتیک غشاء‌های مختلف <i>a</i>) لوله‌ی پر شده با کاتالیست <i>b</i>) یک لایه از کاتالیست درون لوله <i>c</i>) دیواره غشاء به همراه کاتالیست.	۱۶
شکل(۴-۲) تصویر شماتیک از غشاء لوله‌ای نامتقارن	۱۸
شکل(۵-۲) تصویر شماتیک و <i>SEM</i> از غشاء سه لایه شامل زیرلایه، لایه میانی و لایه نهایی.	۲۱
شکل(۶-۲) تصویر شماتیک از تئوری <i>DLVO</i> (سمت راست) و لایه مضاعف الکتریکی(سمت چپ).	۲۴
شکل(۷-۲) بر هم کنش بر حسب فاصله	۲۵
شکل(۸-۲) تصویر شماتیک سه روش عمومی سل-ژل	۳۲
شکل(۹-۲) توزیع اندازه حفرات در ژل سیلیکایی تهیه شده توسط آبکافت <i>TMOS</i> با آب مقطّر و محلول آمونیاکی در $pH = 10$	۳۵

شکل(۱-۲) توزیع اندازه حفرات در ژل سیلیکایی تهیه شده توسط آبکافت *TMOS* با آب
۳۶ مقطر و ژل‌سازی در دماهای مختلف

شکل(۱۱-۲) پارامترهای مؤثر بر مکانیزم‌های پوشش‌دهی فیلم و فیلتراسیون کلوئیدی
۳۸ مؤینگی

شکل(۱۲-۲) *a* و *b*) در مرحله *CRP* هستند *b*) موقعیت نقطه بحرانی *c*) در مرحله *FRPI*، که
۴۲.. فیلم جذب شده در دیواره‌های تخلخل غیر اشباع شده، *w* پهنانی قسمت خشک شده

شکل(۱-۳) تصویر دستگاه پوشش‌دهی به روش غوطه‌وری ۵۱

شکل(۲-۳) سیکل خشک کردن پوشش آلومینایی لایه میانی ۵۲

شکل(۳-۳) سیکل سینتر جزئی پوشش گاما-آلومینا در دمای 600°C ۵۲

شکل(۴-۳) سیکل خشک کردن پوشش سیلیکا-اکسید قلع لایه نهایی ۵۳

شکل(۵-۳) سیکل سینتر جزئی پوشش سیلیکا-اکسید قلع در دمای 500°C ۵۳

شکل(۱-۴) تصویر *SEM* از سطح زیر لایه سینتر شده در 1400°C (بزرگنمایی ۳۰۰۰ برابر).
۵۹

شکل(۲-۴) اندازه و توزیع اندازه تخلخل پایه آلومینایی سینتر شده در 1300°C ۶۰

شکل(۳-۴) منحنی زبری سنجی مربوط به نمونه آلومینایی سینتر شده در 1300°C توسط
۶۱ فرهنگ

شکل(۴-۴) منحنی زبری سنجی مربوط به نمونه آلومینایی سینتر شده در 1300°C ۶۱

شکل(۵-۴) منحنی زبری سنجی مربوط به نمونه آلومینایی سینتر شده در 1400°C توسط
۶۲ فرهنگ

شکل(۶-۴) منحنی زبری سنجی مربوط به نمونه آلومینایی سینتر شده در 1400°C ۶۲

.....	شکل(۷-۴) منحنی زبری سنجی نمونه آلومینایی که ابتدا در دمای 1400°C سینتر و سپس پولیش شده.
۶۳	
.....	شکل(۸-۴) تصویر شماتیک از غشاء نامتقارن چند لایه.
۶۵	
.....	شکل(۹-۴) توزیع اندازه ذرات در سل‌های <i>Al-IP-F</i> و <i>Al-Et-F</i> .
۶۸	
.....	شکل(۱۰-۴) توزیع اندازه ذرات در سل‌های <i>Al-Et-F-PVA</i> و <i>Al-Et-F</i> .
۶۹	
.....	شکل(۱۱-۴) توزیع اندازه ذرات در سل‌های <i>Al-IP-F-PVA</i> و <i>Al-IP-F</i> .
۷۰	
.....	شکل(۱۲-۴) توزیع اندازه ذرات سل <i>Al-Et-Aged</i> و <i>Al-Et-F</i> .
۷۱	
.....	شکل(۱۳-۴) تابع توزیع اندازه ذرات آلومینا در سل <i>Al-IP-Aged</i> و <i>Al-IP-F</i> .
۷۲	
.....	شکل(۱۴-۴) توزیع اندازه ذرات در سل‌های <i>Al-IP-Age</i> و <i>Al-Et-Aged</i> .
۷۲	
.....	شکل(۱۵-۴) الگوی پراش اشعه ایکس لایه میانی آلومینایی پس از عملیات حرارتی در دماهای 110°C ، 400°C و 600°C .
۷۵	
.....	شکل(۱۶-۴) پوشش لایه میانی آلومینایی با سل <i>Al-IP-F</i> بر روی زیر لایه آلفا-آلومینایی متخلخل و عملیات حرارتی شده در دمای 600°C .
۷۷	
.....	شکل(۱۷-۴) سطح لایه میانی پس از پوشش با سل‌های دارای <i>PVA</i> بر روی زیر لایه متخلخل آلفا-آلومینایی (بالا) و عملیات حرارتی شده در دمای 600°C و آنالیز <i>EDX</i> از آن (پایین).
۷۸	
.....	شکل(۱۸-۴) فصل مشترک ناحیه پوشش دیده و بدون پوشش بر روی سطح زیر لایه آلفا-آلومینایی متخلخل و عملیات حرارتی شده در دمای 600°C (بالای نمونه ناحیه بدون پوشش و در پایین قسمت پوشش داده شده).
۷۹	
.....	شکل(۱۹-۴) سطح لایه میانی گاما-آلومینا بر روی زیر لایه آلفا-آلومینا، پس از ۵ بار پوششده با دو سل و عملیات حرارتی در دمای 600°C .
۸۰	

شکل(۴-۲۰) مقطع عرضی نمونه پوشش داده شده با سل کلوئیدی آلومینایی بر روی زیر لایه آلفا-آلومینا متخلخل با دو بزرگ نمایی ۱۰۰۰ برابر (بالا) و ۳۰۰۰ برابر (پایین).	۸۱
شکل(۴-۲۱) تصویر <i>AFM</i> سه بعدی لایه میانی گاما-آلومینایی بر روی زیر لایه آلفا-آلومینا متخلخل.	۸۲
شکل(۴-۲۲) تصویر دو بعدی از سطح پوشش گاما-آلومینا بر روی زیر لایه متخلخل آلفا-آلومینایی به همراه زبری سنجی خط ۱ و میانگین زبری در طول خط.	۸۳
شکل(۴-۲۳) تصویر دو بعدی از سطح پوشش گاما-آلومینا بر روی زیر لایه متخلخل آلفا-آلومینایی به همراه زبری سنجی خط ۲ و میانگین زبری در طول خط.	۸۳
شکل(۴-۲۴) تصویر دو بعدی از سطح پوشش گاما-آلومینا بر روی زیر لایه متخلخل آلفا-آلومینایی و زبری سنجی میانگین سطح.	۸۴
شکل(۴-۲۵) توزیع اندازه ذرات سیلیکا در سل پلیمری.	۸۶
شکل(۴-۲۶) توزیع اندازه ذرات سل حاوی قلع در سل پلیمری.	۸۶
شکل(۴-۲۷) توزیع اندازه ذرات حاوی سیلیکا و قلع در سل های پلیمری با (a) ۵%mol، (b) ۱۰%mol و (c) ۲۰%mol اکسید قلع.	۸۷
شکل(۴-۲۸) آنالیز <i>FTIR</i> سل پلیمری سیلیکا-۵%mol اکسید قلع از ژل خشک شده در دمای ۱۰۰°C به مدت ۲h.	۸۹
شکل(۴-۲۹) آنالیز <i>FTIR</i> سه نمونه سیلیکا حاوی ۵، ۱۰ و ۲۰%mol قلع از ژل خشک شده در ۹۳ در ۱۰۰°C به مدت ۲h.	۹۳
شکل(۴-۳۰) آنالیز <i>FTIR</i> سه نمونه سیلیکا حاوی ۵، ۱۰ و ۲۰%mol قلع پس از عملیات حرارتی در دمای ۱۰۰°C.	۹۵

- شكل(۳۱-۴) آنالیز گرماسنجی افتراقی(DSC-منحنی آبی رنگ) و توزین حرارتی(TGA- منحنی قرمز رنگ) نمونه سیلیکا- حاوی ۱۰%mol قلع. ۹۷
- شكل(۳۲-۴) الگوی پراش اشعه ایکس لایه نهایی سیلیکا-حاوی ۱۰%mol قلع پس از عملیات حرارتی در دماهای ۱۱۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ °C..... ۹۸
- شكل(۳۳-۴) دیاگرام فاز دوتایی SiO_2-SnO ۹۹
- شكل(۳۴-۴) زیرلايه آلومینایی متخلخل پوشش داده شده با سل پلیمری سیلیکا- حاوی ۱۰%mol قلع (بالا) و پوشش سیلیکا-اکسید قلع بر روی زیرلايه چگال آلومینایی(پایین) پس از عملیات حرارتی در دمای ۵۰۰°C..... ۱۰۱
- شكل(۳۵-۴) آنالیز EDX از سطح شیشه پوشش داده شده با سل پلیمری سیلیکا- حاوی ۱۰%mol قلع. ۱۰۲
- شكل(۳۶-۴) سطح لایه نهایی سیلیکا-اکسید قلع بر روی لایه میانی گاما-آلومینا با زیرلايه متخلخل آلفا-آلومینا(بالا) و آنالیز EDX آن(پایین). ۱۰۴
- شكل(۳۷-۴) تصیر سه لایه آلفا-آلومینا، گاما-آلومینا و لایه نهایی سیلیکا- اکسید قلع..... ۱۰۵
- شكل(۳۸-۴) تصویر لایه نهایی سیلیکا-اکسید قلع بر روی لایه میانی گاما-آلومینا با بزرگنمایی ۶۰۰۰۰ برابر. ۱۰۶
- شكل(۳۹-۴) تصویر AFM سه بعدی لایه میانی گاما-آلومینایی بر روی زیرلايه آلفا-آلومینا متخلخل. ۱۰۶
- شكل(۴۰-۴) تصویر دو بعدی از سطح پوشش گاما-آلومینا بر روی لایه میانی متخلخل گاما-آلومینایی به همراه زبری سنجی خط ۱ و میانگین زبری در طول خط. ۱۰۷

- شکل(۴۱-۴) تصویر دو بعدی از سطح پوشش سیلیکا-اکسید قلع بر روی لایه میانی متخلخل گاما-آلومینایی به همراه زبری سنگی خط ۲ و میانگین زبری در طول خط..... ۱۰۸
- شکل(۴۲-۴) تصویر دو بعدی از سطح پوشش لایه نهایی سیلیکا-اکسید قلع بر روی لایه میانی گاما-آلومینایی و زبری سنگی میانگین سطح..... ۱۰۹

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۳	جدول (۱-۱) مثال هایی از فرآیندهای موجود برای جداسازی های محیطی
۱۳	جدول (۲-۱) کاربردهای غشاء گاز به همراه تهیه کنندگان آنها .
۳۶	جدول (۲-۲) میانگین قطر حفرات تخمین زده شده توسط سطح ویژه و دانسیته بالک ..
۴۵	جدول (۳-۲) وضعیت توسعه غشاها .
۶۷	جدول (۴-۱) ویژگی سللهای کلوئیدی آلومینایی.

فصل ١

مقدمة